

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0212U005756

Державний реєстраційний номер: 0112U006001

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 27-12-2012

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Дизайн чутливих до видимого світла фотовольтаїчних комірок на основі квантових точок халькогенідів металів, широкозонних оксидних напівпровідників та похідних графену

Початок етапу: 10.2012

Закінчення етапу: 12.2012

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05417213

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 525-66-62, 525-62-16

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України

Код за ЄДРПОУ: 37200303

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 246-39-10

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрямок фінансування: 2.5 - програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2209020

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 65

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Дизайн чутливих до видимого світла фотовольтаїчних комірок на основі квантових точок халькогенідів металів, широкозонних оксидних напівпровідників та похідних графену

Назва роботи англійською:

Design of visible-light-sensitive photovoltaic cells based on metal chalcogenide quantum dots, wide-band-gap oxide semiconductors, and graphene derivatives

Реферат українською:

Мета проекту полягає в розробці методів формування та електрохімічної характеристики плівкових наногетероструктур на основі широкозонних оксидних напівпровідників (TiO₂, ZnO), модифікованих частково-відновлених графен оксидом та наночастинками халькогенідів металів (CdS, CdSe, PbSe тощо) для створення чутливих до видимого світла елементів фотовольтаїчних перетворювачів сонячної енергії.

Реферат англійською:

The project aims at developing methods for the formation and electrochemical characterization of thin film nanoheterostructures based wide-oxide semiconductors (TiO₂, ZnO), modified partially reduced graphene oxide and metal chalcogenide nanoparticles (CdS, CdSe, PbSe, etc.) to create sensitive to visible light elements fotovoltaichnyh converters solar energy.

Індекс УДК: 544, 541.14

Коди тематичних рубрик: 31.15

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Кучмій Степан Ярославович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Чутливі до видимого світла фотовольтаїчні комірки на основі квантових точок халькогенідів металів, широкозонних оксидних напівпровідників і похідних графена

Назва НТП англійською: Sensitive to visible light photovoltaic cells based on quantum dot chalcogenides metals, semiconductors and wide-oxide derivative of graphene

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати:

Галузь застосування: 73.10.1 Дослідження і розробки в галузі природничих наук

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Фотовольтаїчні комірки на основі квантових точок халькогенідів металів, широкозонних оксидних напівпровідників та похідних графену

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: -

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: виробники сонячних комірок

Перспективні ринки: Україна, країни СНД

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Кошечко Вячеслав Григорович

д. х. н., 02.00.04

Перелік осіб-виконавців

Андрюшина Наталія Сергіївна

Гродзюк Галина Ярославівна

Коржак Ганна Василівна

Кучмій Степан Ярославович

Раєвська Олександра Євгенівна

Строюк Олександр леонідович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

